

# 2015年 第76回 応用物理学会秋季学術講演会 講演募集要項

●登壇申込【電子投稿】締切：2015年6月23日(火)17:00(厳守)

URL：<http://meeting.jsap.or.jp/entry.html>

●会合(IM)申込締切：2015年7月下旬

## 開催期日・場所

期 間:2015年9月13日(日)~16日(水)

場 所:名古屋国際会議場

(愛知県名古屋市熱田区熱田西町1番1号)

## ご注意

現在, 応用物理学会では分科の再編・統合を進めており, 5月中旬より受付を開始する登壇申込時には変更される可能性があります. 登壇申込の画面でよくご確認いただき, 手続きして下さい.

- 登壇申込締切以後の登録内容の修正, 予稿の差し替え, 申込の取消はいたしかねます.
- ご提出いただいた予稿の著作権は応用物理学会に帰属します.
- 発表形式はなるべくご希望に添えるよう努力いたしますが, ご希望に添えない場合がございます. その際, 登壇者の方への事前の連絡はいたしかねますのでご了承下さい.

## 大分類13, 14の編成

2015年春季講演会より, 従来の大分類13, 14が統合・再編され, 一つの大分類(13. 半導体)となりました. ご投稿の際には, 必ず大分類名, 中分類名をご確認下さい.

## コードシェアセッション

2014年秋季講演会からの新たな試みとして, 投稿締切り後のプログラム編成委員会において, 複数中分類間での合同セッションが企画できるようになりました. このため, ご投稿時に希望された中分類ではなく, 他の中分類とのコードシェアセッションに講演がプログラムされる可能性があります.

## 参加予約申込

一般講演を行うにあたっては, 会員登録に伴い発生する入会金・年会費のほかに「講演会参加費」が必要になります. 事前予約申込(8月21日締切)をご利用いただきますと, 当日価格と比べ最大40%割引となります. 大会公式ホームページ, または会員システム・マイページの「講演会参加予約申込」からお申込みいただけますので是非ご利用下さい(5月中旬より受付開始予定).

なお, 未納の会費がある場合にはお支払いが確認でき次第, 参加予約申込が可能になります. まだ会費のお支払いがお済みでない場合には, お早めにお支払いをお願いいたします.

## JSAP-OSA Joint Symposia 2015 について

アメリカ光学会(OSA)とのジョイントシンポジウムを開催します. 本ジョイントシンポジウムでの発表はすべて英語となります. 詳細は大会公式ホームページを御覧下さい.

## 1.一般講演の募集

応用物理学に関する学術成果について、表1～3に示す常設分科、合同セッション、シンポジウムに関する一般講演を募集します。  
 なお、講演日・講演分科はプログラム編集委員会にて決定します。

### ご注意

現在、応用物理学会では分科の再編・統合を進めており、5月中旬より受付を開始する登壇申込時には変更される可能性があります。登壇申込の画面でよくご確認いただき、手続きして下さい。

表1.常設分科 Regular categories

大分類分科名 Category	中分類分科名	Section
1 応用物理学一般 Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology	1.1 応用物理一般・学際領域	Interdisciplinary and General Physics
	1.2 教育	Education
	1.3 新技術・複合新領域	Novel technologies and interdisciplinary engineering
	1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	Energy conversion, storage, resources and environment
	1.5 計測技術・計測標準	Instrumentation, measurement and Metrology
	1.6 超音波	Ultrasonic
	※「1 応用物理学一般」の中分類であった「磁場応用」は、2015年春季講演会より、「10スピントロニクス・マグネティクス」に移動いたしました。1.4「エネルギー変換・貯蔵」と1.5「資源・環境」が統合され、「計測技術・計測標準」及び「超音波」の中分類番号が従来より繰り上がりましてご注意ください。	
2 放射線 Ionizing Radiation	2.1 放射線物理一般・検出器基礎	Radiation physics and Detector fundamentals
	2.2 検出器開発	Detection systems
	2.3 放射線応用・発生装置・新技術	Application, radiation generators, new technology
3 光・フォトニクス Optics and Photonics 2014年秋に従来の大分類3, 4, 5が統合・再編され、1つの大分類になっております。	3.1 光学基礎・光学新領域	Basic optics and frontier of optics
	3.2 材料・機器光学	Equipment optics and materials
	3.3 情報フォトニクス・画像工学	Information photonics and image engineering
	3.4 生体・医用光学	Biomedical optics
	3.5 レーザー装置・材料	Laser system and materials
	3.6 超高速・高強度レーザー	Ultrashort-pulse and high-intensity lasers
	3.7 レーザープロセス	Laser processing
	3.8 光計測技術・機器	Optical measurement, instrumentation, and sensor
	3.9 テラヘルツ全般	Terahertz technologies
	3.10 光子量子物理・技術	Optical quantum physics and technologies
	3.11 フォトニック構造・現象	Photonic structures and phenomena
	3.12 ナノ領域光学・近接場光学	Nanoscale optical science and near-field optics
	3.13 半導体光デバイス	Semiconductor optical devices
	3.14 光制御デバイス・光ファイバー	Optical control devices and optical fibers
	3.15 シリコンフォトニクス	Silicon photonics
4 JSAP-OSA Joint Symposia すべて English Session	4.1 Plasmonics	Plasmonics
	4.2 Bio- and Medical Photonics	Bio- and Medical Photonics
	4.3 Optical Micro-sensing, Manipulation, and Fabrications (仮)	Optical Micro-sensing, Manipulation, and Fabrications
	4.4 Opto-electronics	Opto-electronics
	4.5 Information Photonics	Information Photonics
	4.6 Nanocarbon and 2D materials photonics	Nanocarbon and 2D materials photonics
	4.7 Terahertz Photonics	Terahertz Photonics
6 薄膜・表面 Thin Films and Surfaces	6.1 強誘電体薄膜	Ferroelectric thin films
	6.2 カーボン系薄膜	Carbon-based thin films
	6.3 酸化物エレクトロニクス	Oxide electronics
	6.4 薄膜新材料	Thin films and New materials
	6.5 表面物理・真空	Surface Physics, Vacuum
	6.6 プローブ顕微鏡	Probe Microscopy
	6.7 原子・分子線およびビーム関連新技術	Atomic/molecular beams and beam-related new technologies
7 ビーム応用 Beam Technology and Nanofabrication	7.1 X線技術	X-ray technologies
	7.2 電子ビーム応用	Applications and technologies of electron beams
	7.3 微細パターン・微細構造形成技術	Micro/Nano patterning and fabrication
	7.4 量子ビーム界面構造計測	Buried interface sciences with quantum beam
	7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術	Atomic/molecular beams and beam-related new technologies
	7.6 イオンビーム一般	Ion beams
	※大分類7「ビーム応用」では、2015年春季講演会から中分類の大幅な再編が行われました。投稿に際してどの中分類を選択するかご注意ください。	
8 プラズマエレクトロニクス Plasma Electronics プラズマエレクトロニクス全体で英語セッションを実施	8.0 Plasma Electronics English Session	Plasma Electronics English Session
	8.1 プラズマ生成・制御	Plasma production and control
	8.2 プラズマ診断・計測	Plasma measurements and diagnostics
	8.3 プラズマ成膜・表面処理	Plasma deposition of thin film and surface treatment
	8.4 プラズマエッチング	Plasma etching
	8.5 プラズマナノテクノロジー	Plasma nanotechnology.
	8.6 プラズマライフサイエンス	Plasma life sciences
	8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野	Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications
	8.8 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	プラズマエレクトロニクス分科内招待講演
9 応用物性 Applied Materials Science	9.1 誘電材料・誘電体	Dielectrics, ferroelectrics
	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	Nanowires and Nanoparticles
	9.3 ナノエレクトロニクス	Nanoelectronics
	9.4 熱電変換	Thermoelectric conversion
	9.5 新機能材料・新物性	New functional materials and new phenomena
	9.6 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	Emerging materials in spintronics and magnetism (excluding semiconductors)
10 スピントロニクス・マグネティクス Spintronics and Magnetism	10.1 スピントルク・スピントロニクス・回路・測定技術	Spin torque, spin current, circuits, and measurement technologies
	10.2 GMR・TMR・磁気記録技術	Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies
	10.3 半導体・有機・光・量子スピントロニクス	Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics
	10.4 磁場応用	Application of magnetic field
	※「1 応用物理学一般」の中分類であった「磁場応用」は、2015年春季講演会より、「10 スピントロニクス・マグネティクス」に移動いたしました。	
11 超伝導 Superconductivity	11.1 基礎物性	Fundamental properties
	11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長	Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth
	11.3 臨界電流、超伝導パワー応用	Critical Current, Superconducting Power Applications
	11.4 アナログ応用および関連技術	Analog applications and their related technologies
	11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用	Junction and circuit fabrication processes, digital applications

12 有機分子・バイオエレクトロニクス Organic Molecules and Bioelectronics 2014年春に中分類が再編されておりますので、ご確認のうえご投稿ください。	12.1	作製・構造制御	Fabrications and Structure Controls
	12.2	評価・基礎物性	Characterization and Materials Physics
	12.3	機能材料・萌芽的デバイス	Functional Materials and Novel Devices
	12.4	有機EL・トランジスタ	Organic light-emitting devices and organic transistors
	12.5	有機太陽電池	Organic solar cells
	12.6	ナノバイオテクノロジー	Nanobiotechnology
	12.7	医用工学・バイオチップ	Biomedical Engineering and Biochips
13 半導体 Semiconductors 2015年春季講演会より、従来の大分類13, 14が統合・再編され、1つの大分類になりました。	13.1	Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials
	13.2	探索的材料物性・基礎物性	Exploratory Materials, Physical Properties, Devices
	13.3	絶縁膜技術	Insulator technology
	13.4	Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	Si wafer processing /MEMS/Integration technology
	13.5	デバイス/集積化技術	Semiconductor devices and related technologies
	13.6	Semiconductor English Session	Semiconductor English Session
	13.7	ナノ構造・量子現象	Nano structures and quantum phenomena
	13.8	化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術	Compound and power electron devices and process technology
	13.9	光物性・発光デバイス	Optical properties and light-emitting devices
	13.10	化合物太陽電池	Compound solar cells
15 結晶工学 Crystal Engineering	15.1	バルク結晶成長	Bulk crystal growth
	15.2	II-VI族結晶および多元系結晶	II-VI and related compounds
	15.3	III-V族エピタキシャル結晶	III-V-group epitaxial crystals
	15.4	III-V族窒化物結晶	III-V-group nitride crystals
	15.5	IV族結晶, IV-IV族混晶	Group IV crystals and alloys
	15.6	IV族系化合物	Group IV Compound Semiconductors
	15.7	エピタキシーの基礎	Fundamentals of epitaxy
	15.8	結晶評価, 不純物・結晶欠陥	Crystal evaluation, impurities and crystal defects
16 非晶質・微結晶 Amorphous and Microcrystalline Materials	16.1	基礎物性・評価	Fundamental properties and their evaluation in disordered materials
	16.2	エナジーハーベスティング	Energy Harvesting
	16.3	シリコン系太陽電池	Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells
	※大分類16「非晶質・微結晶」では2015年秋季講演会より再編を予定しております。登壇の際には最新の分類にご留意の上、登壇下さい。		
17 ナノカーボン Nanocarbon Technology	17.1	成長技術	Growth technology
	17.2	構造制御・プロセス	Structure control and process
	17.3	新機能探索・基礎物性評価	Exploration of new functions and evaluation of basic properties
	17.4	デバイス応用	Device applications

※一般セッションからシンポジウムに回ることがございますのでご了承下さい。

※2014年秋季講演会からの新たな試みとして、投稿締切り後のプログラム編成委員会において、複数中分類間での合同セッションが企画できるようになりました。このため、ご投稿時に希望された中分類ではなく、他の中分類とのコードシェアセッションに講演がプログラムされる可能性があります。

表 2. 合同セッション Joint sessions

合同セッションK 「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」 Joint Session K "Wide bandgap oxide semiconductor materials and devices"	薄膜・表面の6.3酸化物エレクトロニクス, 6.4薄膜新材料, および結晶工学15.2 II-VI族結晶および多元系結晶で企画した合同セッションです。	This is a joint session of 6.3 Oxide-based electronics, 6.4 New thin film materials in 6. Thin Films and Surfaces and 15.2 II-VI-group crystals and multicomponent crystals in 15. Crystal Engineering.
--	---	---

表 3. シンポジウム Symposiums (5月15日時点)

一般講演の投稿論文を受け付けいたします。ただし、御希望に添えず「表 1. 常設分科」, 「表 2. 合同セッション」に回ることもありますので、あらかじめご了承下さい。

開催日	大分類名
	シンポジウムタイトル
9/13(日)	12.有機分子・バイオエレクトロニクス 有機エレクトロニクスの萌芽的研究 Seeds Researches in Organic Electronics
	13.半導体 界面ナノ電子化学「進化する半導体ウェットプロセス ～シリコンから化合物まで～」 Progress of semiconductor wet processing - from silicon to compound -
	13.半導体 原子・電子構造制御による次世代デバイス開発に向けた基礎研究と新展開 —多元系化合物ベースの次期太陽電池・新規熱電物質・電子相関物質— New approach to the next-generation device using multinary compounds - novel fields of solar cells, thermoelectric materials, magnetic-dielectric materials -
	13.半導体 Ge-CMOSはどこまで進んでいるのか What is the last nob of Ge-CMOS?
	16.非晶質・微結晶 液体シリコンの科学と最新動向 Science and recent trend of liquid silicon
9/14(月)	17.ナノカーボン 機能性原子薄膜化合物材料の応用展開 Trend of Functional Atomic Thin Film Application
	1.応用物理学一般 企業・地域等が連携したサイエンスコミュニケーション(仮) Science Communication Associated with Companies and Communities and so on (tentative)
	2.放射線 化学分析技術と放射線 Radiation application in chemical analysis

9/14(月)	3.光・フォトニクス フォトニクス分科会発足記念シンポジウム「フォトニクスの夢」 Symposium to Commemorate the Foundation of Photonics Division, "Dream in the Photonics"
	6.薄膜・表面 International Symposium on Thin Film Technologies for Flexible Devices
	6.薄膜・表面.9.応用物性 誘電体・強誘電体材料およびデバイスの新展開を求めて In search of the new development of dielectric and ferroelectric materials and their devices
	8.プラズマエレクトロニクス プラズマ医療科学の最前線 Frontier of Plasma Medicine
	12.有機分子・バイオエレクトロニクス ナノバイオテクノロジーに関するジョイントシンポジウム Asian Joint Symposium on Nanobiotechnology
	12.有機分子・バイオエレクトロニクス 有機無機ペロブスカイト太陽電池の現状と今後の展望 Present Situation and Future Prospects of Organic-Inorganic Perovskite Solar Cells
	13.半導体 越境する絶縁膜/半導体界面技術 ~ Si から Non-Si ~ ~ Dielectric Thin Film Technology Beyond Borders: From Si to Non-Si
	15.結晶工学 窒化物半導体を用いた新機能半導体レーザの創出とその応用 New functional GaN-based laser diodes and the applications
	合同セッションK 窒化物半導体の評価技術 Evaluation technology for oxide semiconductor
	3.光・フォトニクス 量子情報へ向けたシリコンテクノロジーからの挑戦 Quantum Silicon Technology from the ground up
	6.薄膜・表面 機能性材料・デバイス解析の最近の動向 Recent Trend of Analysis Techniques for Functional Materials and Devices
	6.薄膜・表面 機能性酸化物の原子・ナノスケール機能開拓最前線 Forefront of research on atomic and nano-scaled functionalities in oxides
	10.スピントロニクス 新規スピントロニクス現象と応用の可能性 The New Spintronics Phenomena and Potential for the Applications
	15.結晶工学 窒化物半導体特異構造の科学 ~表面・界面の制御と物理~ Materials science of singularity in nitride semiconductors -Control and physics on surface and interface-

## 2.講演奨励賞

応用物理学の発展に貢献しうる優秀な論文を発表した若手会員(発表年月日以降の4月1日時点で満33歳以下)に対して「講演奨励賞」が授与されます。応募される方は、登壇申込の申請希望欄の「申請する」を選び該当箇所を入力して下さい。

プログラムに講演奨励賞申請講演である旨が明示されます。講演奨励賞の詳細については次頁を参照して下さい。

## 3.一般講演投稿要領

### 3.1 登壇資格

一般講演(口頭講演,ポスター講演)の登壇者は応用物理学会の正会員,学生会員に限ります。なお,APS(American Physical Society), EOS (European Optical Society), EPS(European Physical Society), IOP(Institute of Physics), KPS(Korean Physical Society), OSA(Optical Society of America), PSROC(The Physical Society of Republic of China), SPIE,OSK(Optical Society of Korea), TPS(Taiwan Photonics Society), SFP(フランス物理学会), 日本物理教育学会の会員は,応用物理学会正会員扱いとなります。

一般講演における会員1人あたりの登壇件数は口頭講演とポスター講演をあわせて原則3件までとします。4件以上の登壇を希望する場合は,受理の判断材料として,各予稿の内容に重複がない旨の説明書を投稿/切日迄に提出して下さい。説明書の書式は自由ですが,簡潔に説明して下さい。

### 3.2 登壇申込締切時間

**登壇申込締切:2015年6月23日(火)17:00(厳守)**

### 3.3 申込先

登壇申込

URL : <http://meeting.jsap.or.jp/entry.html>

## 4.予稿原稿(PDF)執筆要領

講演予稿原稿は,講演会参加者に予め講演の内容を知らせ,あるいは講演を聴けない人にもその概要を知らせる重要なデータベースです。受理された予稿原稿ファイル(PDF)がそのままDVD-ROMに収録されます。以下の要領に従って読みやすく理解しやすい予稿原稿を,日本語あるいは英文で作成して下さい。なお,連名の場合には,著者全員の承諾を得て下さい。また,勤務先(研究場所)などからも必要な承諾を得て下さい。

タイトル 著者・所属・E-mail
1段組若しくは2段組で作成して下さい。図表はカラーで作成いただいても結構です。予稿はカラーで表示されます。
<b>予稿は1ページで作成して下さい。</b>

- ① 題目:「について」を省く,「その一,その二」は「I, II」にするなど,簡潔にして要を得た題目にして下さい。また,英文を併記して下さい。
- ② 勤務先(研究場所)・氏名:勤務先(研究場所)は略称を用いるなどして簡潔に表現して下さい。また,英語名称を併記して下さい。

- ③ 登壇者等の E-mail : 登壇者・連絡責任者の E-mail アドレスをできるだけ記入して下さい。ホームページがあればそのアドレスも記入して下さい。
- ④ 本文: 講演の要旨(原著であること)とそれを得るに至ったデータの中で特に必要と考えられるもののみを記入して下さい。重要な内容に読者が注目できるよう、優先順位を考慮しながら記載して下さい。本文が日本文の場合も **図表とその説明文は英文を使用して下さい。**
- ⑤ その他作成上の注意: 登壇申込の web サイトに掲載されているテンプレートを使用して作成して下さい。

## 5. 予稿原稿(PDF)の取り扱い

- ① プログラム編集委員会で申込希望分科に沿ってプログラムを編成します。ただし、**プログラム編成の都合により登壇申込時の発表分科を変更いただくことがあります。**
- ② 講演番号通知: E-mail でお知らせします(7月上旬)。プログラムの詳細は本会ホームページ(7月中旬)および機関誌「応用物理」8月号に掲載します。
- ③ 作成された原稿を Adobe Reader で閲覧し、文字化けがないことを確認して下さい。すべてのフォントの「埋め込み」を必ず行って下さい。
- ④ DVD-ROM に収録された予稿の著作権は公益社団法人応用物理学会に帰属します。また、同予稿はそのままの形で国立情報学研究所のデータベースに収録されます。
- ⑤ 予稿原稿は講演会 WEB プログラムに掲載されます。
- ⑥ 予稿原稿および講演申込部分の記載内容に関する責任は著者が負うものとします。
- ⑦ **投稿締切後の予稿原稿および登壇申込部分の書き換え、あるいは取り下げは一切認められません。**
- ⑧ 応用物理学(広義の)に関する内容以外を含むもの、一般講演投稿要領、予稿原稿執筆要領あるいはインターネット電子投稿要領を著しく逸脱するもの、あるいは本会の品位と信用を損なう恐れがあるものと判断される講演申込は受理しません。

## 6. インターネット電子投稿要領

- ※講演発表者は **3.1 登壇資格**を確認の上、非会員の方は入会手続と入会支払を済ませて登録して下さい。
- ※申込締切間際は、大変な混雑が予想されます。できるだけ早い時期の申込をお願いします。

登壇申込についての問合せ先

E-mail : meeting@jsap.or.jp

### <注意事項>

- ・発表形式は「ポスター講演」「口頭講演」「どちらでも良い」のいずれかを選択して下さい。なお、決定はプログラム編集委員会で行います。
- ・登録が正常に受け付けられると、登録完了画面が表示され、電子メールでも登録確認メールが配信されます。今後の登録内容の確認・修正や PDF 送信等に必要ですので、**画面をプリントアウトして必ず保管して下さい。**
- ※登録完了画面から、続けて予稿原稿の PDF ファイルを送信するボタンがあります。
- ・電子メールの受信を必ず確認して下さい。電子メールが届かない場合は正常に登録されていない可能性があります。電子メールが届かない場合は、ホームページの“よくあるご質問”をご確認下さい。
- ・ファイルサイズが **700KB** を超えるファイルは送信することができません。
- ・PDF 送信は、必ず登壇申込の手続きを済ませてから行って下さい。
- ・PDF ファイルにはセキュリティ設定をかけないで下さい。
- ・登壇申込締切までに予稿 PDF 原稿が送信されていない場合は**取り下げとします。**

### <登録内容の確認・修正>

登録済の講演内容は、**締切日(2015年6月23日(火)17:00)**迄は確認・修正が可能です。

### <PDF ファイルの差替え>

一度送信された予稿原稿は、**締切日(2015年6月23日(火)17:00)**迄は差替えることができます。

### <登壇の取消>

登録済の登壇申込内容は、**締切日(2015年6月23日(火)17:00)**迄は取消が可能です。

## 7. 発表形式(一般講演)

### 7.1 口頭講演およびショート口頭講演

パソコンからのプロジェクター投影によるプレゼンテーションです。パソコンは共通仕様の物を学会で用意します。OS は Windows7 Pro, プレゼンテーションソフトは Microsoft Power Point 2007 を予定しています(持ち込みのパソコンも使用できます)。

### 7.2 ポスター講演

備え付けのパネル(1講演につき、**縦 180cm, 横 90cm**)に各自が用意したポスター、図表、写真などを適宜レイアウトして貼り付け、展示時間内で質疑応答を行います。

※2015年春季学術講演会より、ポスターに QR コードを貼り付け、音声案内をすることが可能となります(任意)。貼り付け方等は追ってホームページにてお知らせいたします。

## 8. 講演時間(一般講演 1 件あたり)

### 8.1 口頭講演

持ち時間 15 分(講演 10 分, 質疑応答 5 分)

### 8.2 ポスター講演

持ち時間 2 時間 (コアタイム; 講演番号の順番が奇数の方は前半 1 時間, 講演番号の順番が偶数の方は後半 1 時間)

### 8.3 ショートプレゼンテーション付ポスター講演

ショート口頭講演 2 分(質疑応答なし)とポスター講演

## 第 39 回応用物理学会「講演奨励賞」公募会告

応用物理学会は春秋講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対し、以下のとおり「講演奨励賞」を贈ることによりいたしております。多数の方々への応募を期待いたします。

**受賞対象者** 2015 年第 76 回応用物理学会秋季学術講演会で応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演(ポスターセッションを含む)を発表した本学会会員であり、以下の資格を有する者。

なお、毎回の受賞論文件数は一般講演件数の原則 1%以内と定められています。

- (1) 発表年月日以降の 4 月 1 日時点で満 33 才以下の者
- (2) 論文の筆頭著者であること
- (3) 登録された登壇者であり、かつ実際に登壇した者
- (4) 講演申込時に講演奨励賞を申請(ただし各回 1 人 1 件に限る)した者

**申込手続き** 講演申込(web)の所定の入力欄に講演題目、氏名、所属、生年月日、論文の成果の位置付け、特筆すべき点など必要項目を入力して申し込んで下さい。

**贈呈式** 2016 年春季講演会期間中に行います。受賞者には賞状と記念品を贈呈いたします。

**受賞記念講演** 2016 年春季講演会期中に行います。受賞者には別途ご案内いたします。

**申込期限** 登壇申込締切：2015 年 6 月 23 日(火)17:00  
**URL** <http://meeting.jsap.or.jp/entry.html>

## 講演奨励賞規程

1. 本規程は公益社団法人応用物理学会が若手会員に対して行う表彰に関して定めたものである。

2. 本表彰は、本会の春秋講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対し「講演奨励賞」を授与し、その功績を称えることを目的とする。

3. 表彰対象は本会の春秋講演会で、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文(ポスターセッション論文を含む)を発表した本学会会員であり、かつ本講演奨励賞をまだ受賞していない者であって、以下の資格を有する者とする。

- (1) 発表年月日以降の 4 月 1 日時点で満 33 才以下の者
- (2) 論文の筆頭著者であること
- (3) 登録された登壇者であり、かつ実際に登壇した者
- (4) 講演申し込み時に、講演奨励賞を申請(ただし各回 1 人 1 件に限る)した者
- (5) 表彰時に本学会会員であること

4. 論文発表者で、会員外(分科会会員、相互協定を締結した学協会の会員および非会員)の者は表彰対象としない。

5. 受賞者は半年後の本会の春秋講演会において表彰するとともに、表彰対象者の一覧表を掲示する。

6. 受賞者には会長名の賞状を授与し、記念品を贈呈する。

7. 表彰は表彰時点における公益社団法人応用物理学会会長名により行う。

8. 講演会企画運営委員会は春秋講演会において、表彰の対象となる論文を原則として一般投稿件数の 1%以内を限度として選び、推薦理由を付して理事会に推薦する。

9. 理事会は講演会企画運営委員会の結果を審議し、受賞者を決定する。

10. 理事会は受賞者決定後すみやかに該当者に通知し、かつ会誌に公示する。

11. 本規程は理事会の承認を経て改定することができる。

**付 則**

1. この規程は 1996 年 2 月 23 日理事会にて決定。
2. この規程は 1996 年 4 月 1 日より施行する。
3. 2000 年 11 月 20 日理事会一部変更。

4. 2014 年 7 月 11 日理事会一部改正。

## Poster Award 規程

1. この規程は、公益社団法人応用物理学会(以下「本会」という。)が本学会員に対して行う Poster Award に関して定めたものである。

2. Poster Award は、本会の応用物理学会春季学術講演会および応用物理学会秋季学術講演会(以下「講演会」という。)において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀なポスター講演を行った会員を表彰し、その成果を称えることを目的とする。

3. 表彰対象は、本会の講演会で発表された、応用物理学の発展に貢献しうる優秀なポスター講演で、以下(1)～(2)の条件を全て満たす著者を表彰する。

**(1)ポスター講演を行った時点で本学会員であること**

**(2)講演申し込み時に、登録された著者であること**

4. ポスター講演の著者で、会員外(分科会 A 会員、相互協定を締結した学協会の会員及び非会員)の者は表彰対象としない。

5. Poster Award の選考手順は、別途内規で定める。

6. 表彰の対象となるポスターは、ポスター講演総数の概ね 2%以内とする。

7. 受賞者には本学会会長名の賞状を授与する。

8. 表彰は表彰時点における本学会会長名により行う。

9. 受賞ポスターは、講演会会期中、会場に掲示する。

10. 表彰されたポスターについては、講演会企画運営委員会及び理事会に報告する。

11. 本規程の改正は総務担当理事が承認し理事会へ報告する。

**付 則**

1. この規程は 2013 年 2 月 15 日理事会にて決定。

2. この規程は 2013 年 2 月 15 日より施行する。

3. 2014 年 7 月 8 日 第 10 条、第 11 条改正 総務担当理事承認。

## 参考：Poster Award 概要

### <受賞対象>

2015 年第 76 回応用物理学会秋季学術講演会において実際に実施されたポスター講演

### <選考方法>

#### step1)会場審査

講演当日、ポスター世話人が「ノミネート候補」となったポスター講演の内容を講演開始 30 分間で精査し、最終的な選考対象を決定します。

#### step2)投票・選出

選考対象ポスターについて、講演会企画運営委員長・副委員長およびポスター世話人を含む選考委員会で受賞ポスターを選出します。

・ノミネート候補となった方には事前にお知らせしますので、講演会当日は開始前にポスターの貼付を完了し、セッション開始 30 分間はポスターの前から離れないようお願いいたします。

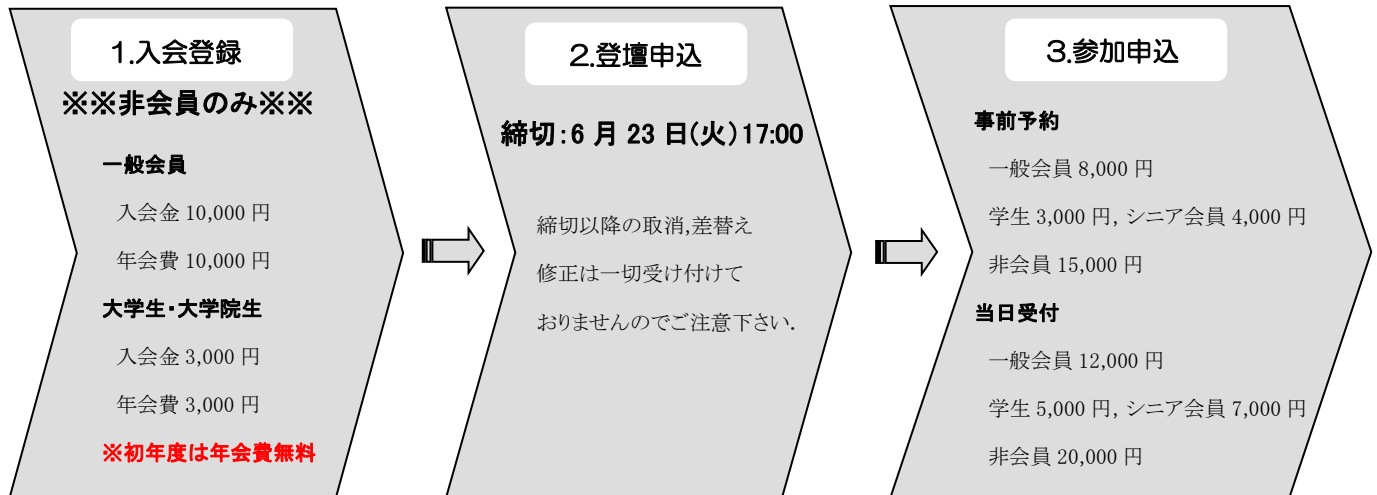
・最終的な選考対象として選定された場合は、当日の発表者に通知いたします。受賞者には表彰状を授与いたします。(授与時期未定)

・Poster Award の表彰対象は、本会正会員(学生会員を含む)になりますので、表彰を希望される場合は、ポスター講演時までに、入会手続きをお願いします。

※2015 年春季学術講演会より、ポスターに QR コードを貼り付け、音声案内をすることが可能となりました(任意)。特に、Poster Award のノミネート候補となった方は、音声案内に是非ともご協力ください。貼り付け方等は追ってホームページにてお知らせいたします。

登壇申込締切:2015年6月23日(火)17時

## 一般講演で登壇するための3つのステップ



2014 秋季講演会より, 会員の方は会員マイページからのお申込みとなりました。未納の会費がある場合には, お支払いが確認でき次第, お申込みが可能になります。